

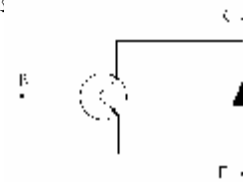
# 13005D

## 硅 NPN 高压率开关晶体管芯片 (4")

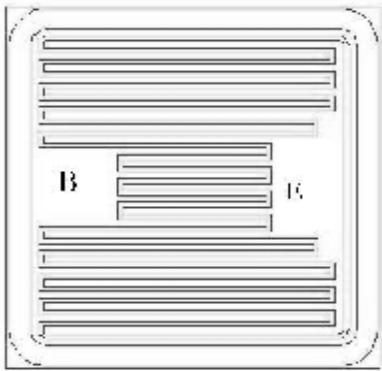
### ■ 用途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

### ■ 内部



### ■ 芯片示意图



### ■ 芯片结构

芯片尺寸	2510×2510μm <sup>2</sup>
压焊区尺寸	基区 520μm×560μm 发射区 470μm×680μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	75μm
金属层	正面: Al 3.5±0.4μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

### ■ 电特性(T<sub>a</sub>=25℃)

项 目	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单 位
集电极-基极反向电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =0.95BV <sub>CB0</sub> , I <sub>E</sub> =0		1		μA
发射极-基极反向电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =9V		1		μA
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =0.1mA	600		760	V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =1mA	400		440	V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =0.1mA	9			V
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =500mA	15	30		
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.5A		0.5		V